НОРМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЕ С МАГНИТО-АКУСТИЧЕСКИМ СЛОЕМ

Карпук М.М., Кузавко Ю.А., Склипус Б.Н.

Брестский политехнический институт

При распространении упругих волн (УВ) через пластинку, зажатую между двумя твердыми полупространствами, в зависимости от соотношения упругих констант материалов, составляющих такую слоистую структу-

ру, и фазовой толщины пластинки $\varphi = Kd$ ($K = \frac{2\pi}{\lambda}$ - волновое число,

 λ - длина волны, d - толщина пластинки), возникают интересные особенности для отраженных и прошедших волн [1]. В частности, при определенных соотношениях вышеуказанных параметров может возникать полное отражение звуковых колебаний, т.е. такая пластинка становится звукоизоляционной.

В данной работе рассматривается нормальное падение продольной и поперечной УВ на слой магнитоакустического материала (MAM), которым, например, является легкоплоскостной ферромагнетик гематит α -Fe₂O₃, находящийся в области ориентационного фазового перехода \hat{H}_0 , приложенному в базисной плоскости кристалла ху [2].

На рисунке показаны направления возникающих отраженных и прошедших волн, а также колебания в слое. Для МАМ слоя скорости поперечных и продольных волн запишутся:

$$\widetilde{S}_t = S_t (1 - \varsigma \cos^2 2\alpha)^{\frac{1}{2}}, \qquad (7)$$

279

$$\widetilde{S}_{l} = S_{l} (1 - t\varsigma \sin^{2} 2\alpha)^{\frac{1}{2}}, \qquad (8)$$

где $S_t = (\frac{\mu}{\rho})^{\frac{1}{2}}$ и $S_l = [(\lambda + 2\mu)/\rho]^{\frac{1}{2}}$ - скорости неподверженного магнитоупругому (МУ) взаимодействию звука, $t = \frac{S_t^2}{S_t^2}$, ρ - плотность, λ и μ - коэффициенты Ламэ, α - угол между нормалью к пластинке и внешним магнитным полем $\frac{1}{H_0}$, $\varsigma = \frac{\omega_{me}}{\omega_{1S}}^2$ - параметр МУ связи, $\omega_{me}^2 = g^2 \cdot 2H_E H_{me}$ - МУ щель в спектре спиновых волн, $\omega_{1S}^2 = \theta_N^2 (aK)^2 + g^2 [H_0 (H_0 + H_D) + 2H_E H_{me}]$ - закон дисперсии нижней ветви стиновых волн, θ_N - приведенная температура Нееля, а - параметр кристаллической решетки, H_E , H_D , H_m - эффективные поля обмена,

Дзялошинского-Мория, магнитострикции.



Новые технологии в машиностроении и вычислительной технике

Рис. Нормальное распространение продольных (а) и поперечных (б) акустических волн в слоистой структуре.

8. Современные проблемы электроники и автоматики

При нормальном падении упругой волны не происходит изменения ее поляризации. Возникают отраженная, прошедшая и распросграняющиеся во взаимно противоположных направлениях в слое волны. Предполагая волны плоскими и гармоническими, для упругих смещений в продольных падающей, отраженной, в слое и прошедшей волн получаем

$$U_1^{T} = U_{110}^{T} \exp(-iK_{11}y - i\omega t), \qquad (9)$$

$$U_{1}^{R} = U_{1/0}^{R} \exp(iK_{1/y} - i\omega t), \qquad (10)$$

$$U^{\pm} = U_{1l0}^{\pm} \exp(\pm iK_{l}y - i\omega t), \qquad (11)$$

$$U_{2}^{T} = U_{10}^{T} \exp(-iK_{21}y - i\omega t). \quad (12)$$

Аналогичные соотношения справедливы и при падении поперечной волны с заменой в (1)-(4):

 $U_{1l0}^{\ \ l} \to U_{1t0}^{\ \ l}, U_{1l0}^{\ \ R} \to U_{1t0}^{\ \ R}, U_{l0}^{\ \ \pm} \to U_{t0}^{\ \ \pm}, U_{2l0}^{\ \ T} \to U_{2l0}^{\ \ T},$ $K_{1l} \to K_{1t}, K_{l} \to K_{t}, K_{2l} \to K_{2t}$. Индексы *l* и *t* определяют соответственно тип поляризации волны.

Особенности проявляются с периодичностью 90° при изменении ориентации поля \vec{H}_0 . Здесь анализируем только данные ситуации. Для произвольной ориентации поля \vec{H}_0 результаты для R_b T_t и R_b T_t могут быть получены тривиальной перенормировкой скоростей звука \widetilde{S}_t и \widetilde{S}_t в заключительных формулах.

Свободная энергия МАМ запишется следующим образом [2]:

$$F_{y} = \frac{1}{2}\lambda U_{ii}^{2} + \mu U_{ik}^{2} - 2\mu \xi U_{xy}^{2} \qquad (13)$$

Для материалов 1 и 2 слоистой структуры справедливо выражение (7) без третьего слагаемого с собственными материальными константами. Из формулы (7) рассчитываются упругие напряжения:

Новые технологии в машиностроении и вычислительной технике

$$\sigma_{ik} = \frac{\partial F_{y}}{\partial U_{ik}}, \qquad (14)$$

где U_{ik} - тензор упругих деформаций.

Волновое уравнение для упругих колебаний имеет вид:

$$\rho \ddot{U}_{i} = \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_{k}} \tag{15}$$

Решая его для трех рассматриваемых сред и используя граничные условия

$$\sigma_{ik}^{(1)} n_k = \sigma_{ik} n_k, U_i^{(1)} = U_i \text{ при } y = d, \quad (16)$$

 $\sigma_{ik} n_k = \sigma_{ik}^{(2)} n_k, U_i = U_i^{(2)} \text{ при } y = -d, \quad (17)$

где $n_k = (0; 1; 0)$ – нормаль к границе сред, находятся коэффициенты отражения $R_l = \frac{U_{1/0}^R}{U_{1/0}^I}$ и прохождения $T_l = \frac{U_{2/0}^T}{U_{1/0}^I}$ продольной волны. Аналогич-

но расчеты проводятся для поперечной волны с соответствующими значениями материальных констант.

Отметим, что продольная магнитоакустическая волна (МАВ) наиболее подвержена МУВ при ориентации поля \vec{H}_0 под углом 45° к оси \vec{y} . Тогда в выражении (2) $\sin^2 2\alpha$ обращается в единицу. Для поперечных МАВ максимальный эффект изменения скорости звука наблюдается при совпадении ориентации поля \vec{H}_0 и оси \vec{y} . При этом вышеуказанные осоДля коэффициентов отражения R_l и прохождения T_l продольной волны в такой слоистой структуре получаем:

$$R_{l} = \frac{(z_{1l} - z_{2l})\widetilde{z}_{l} + itg 2\Psi_{l}(z_{1l}z_{2l} - \widetilde{z}_{l}^{2})}{(z_{1l} + z_{2l})\widetilde{z}_{l} + itg 2\Psi_{l}(z_{1l}z_{2l} + \widetilde{z}_{l}^{2})},$$
(18)

$$T_{l} = -\frac{2z_{1l}\widetilde{z}_{l}e^{-i\Psi_{2l}}}{\cos 2\Psi_{l}(z_{1l} + z_{2l})\widetilde{z}_{l} + i\sin 2\Psi_{l}(z_{1l}z_{2l} + \widetilde{z}_{l}^{2})},$$
(19)

283

где $z_{...} = \rho_{...} \bullet S_{...} \bullet S_{...}$ акустический импеданс, $2\Psi_l = 2K_l d - \phi$ азовая толщина пластинки.

Для коэффициентов отражения R_i и прохождения T_l поперечной волны справедливы соотношения (12) и (13) с заменой z_{1l} , z_b , $z_{2l} \rightarrow z_{1l}$, z_b , z_{2l} и $\Psi_l \rightarrow \Psi_l = K_l d$. Отметим, что коэффициенты R и T согласно (12), (13) являются комплексными: $R = |R| e^{i\varphi_R}$ и $T = |T| e^{i\varphi_T}$, где модули R и Tопределяют амплитудно-частотные характеристики при отражении и прохождении, а фазы ϕ_R и ϕ_T – фазо-частотные характеристики.

Если в (12), (13) Ψ_l соответственно равны $\pi/4$ или $\pi/2$, то о слое МАМ можно говорить как о четвертьволновой или полуволновой пластинке. Тогда из (12), (13) получим:

$$R_{l}(2\Psi_{l} = \pi/2) = \frac{z_{1l}z_{2l} - \tilde{z}_{l}^{2}}{z_{1l}z_{2l} + \tilde{z}_{l}^{2}}, \qquad (12')$$
$$T_{l} \mid (2\Psi_{l} = \pi/2) = \frac{2z_{1l}\tilde{z}_{l}}{z_{l} - \tilde{z}_{l}}, \qquad (13')$$

$$T_{l} | (2\Psi l = \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{z_{1l} z_{2l} + \tilde{z}_{l}^{2}}, \quad (13')$$

$$R_l(2\Psi l = \pi) = \frac{z_{1l} - z_{2l}}{z_{1l} + z_{2l}} , \qquad (12")$$

$$T_{l}(2\Psi l = \pi) = -\frac{2z_{1l}}{z_{1l} + z_{2l}}, \qquad (13")$$

Откуда видно, что для четвертьволновой пластинки с импедансом $Z_1 = \sqrt{Z_{1/}Z_{2/}}$ полностью отсутствует отражение и получается полное прохождение звука через нее, а для полуволновой пластинки отражение и прохождение волны идентично случаю прохождению ею границы двух сред (влияние пластинки согласно 12', 12" полностью отсутствует). Так как в соотношениях (10), (11) акустический импеданс \tilde{Z} зависит в конечном итоге от внешнего магнитного поля, то такие пластинки становятся управляемыми с помощью поля интенсивностью отраженных либо прошедших Новые технологии в машиностроении и вычислительной технике

волн и могут использоваться в функциональных устройствах твердотельной акустоэлектроники.

Литература

- 1. Л.Ф.Лепендин. Акустика/ М.: Высшая школа. 1978. с.448.
- Ю.А.Кузавко, В.Г.Шавров. Отражение магнитоакустических волн в окрестности спиновой переориентации// Акустический журнал. 1993. Т.39. №6. С.1088-1092.

УДК 681.325

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСТРОВОГО СОПРЯЖЕНИЯ ОПТОЭЛЕКТРОННОГО ДАТЧИКА ДЛЯ КОММУТАЦИИ БЕСКОЛЛЕКТОРНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Бусел Н.П.

Могилевский машиностроительный институт

При формировании квадратурных гармонических сигналов в оптоэлектронных датчиках для коммутации бесколлекторных электродвигателей воспользуемся растровым сопряжением из модулятора с радиальными штрихами и неподвижной маски со считывающим окном ступенчатой формы, обеспечивающем кусочно-линейную аппроксимацию задаваемой гармонической функции. Для оптимизации конструктивных параметров такого растрового сопряжения примем за основу число периодов p формируемого гармонического сигнала и ширину b площадки фотоприемника, после чего обратимся к геометрической интерпретации задачи, представленной на рисунке 1.